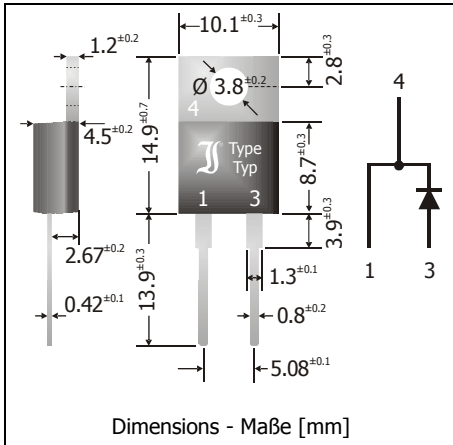


MBR10100

High Temperature Schottky Rectifier Diodes – Single Diode Hochtemperatur Schottky-Gleichrichterdiodes – Einzeldiode

Version 2015-01-14



- Nominal current / Nennstrom 10 A
- Repetitive peak reverse voltage / Periodische Spitzensperrspannung 100 V
- Plastic case – Kunststoffgehäuse TO-220AC
- Weight approx. / Gewicht ca. 1.8 g
- Plastic material has UL classification 94V-0 / Gehäusematerial UL94V-0 klassifiziert
- Standard packaging in tubes / Standard Lieferform in Stangen



Maximum ratings and Characteristics

Grenz- und Kennwerte

Type Typ	Repetitive peak reverse voltage Periodische Spitzensperrspannung V_{RRM} [V]	Surge peak reverse voltage Stoßspitzensperrspannung V_{RSM} [V]	Forward voltage Durchlass-Spannung V_F [V] ¹⁾	
			$I_F = 5 A$	$I_F = 10 A$
MBR10100	100	100	tbd	< 0.8

Max. average forward rectified current, R-load Dauergrenzstrom in Einwegschaltung mit R-Last	$T_C = 125^\circ C$	I_{FAV}	10 A
Repetitive peak forward current Periodischer Spitzenstrom	$f > 15 Hz$	I_{FRM}	30 A ²⁾
Peak forward surge current, 50/60 Hz half sine-wave Stoßstrom für eine 50/60 Hz Sinus-Halbwellen	SBT1090... $T_A = 25^\circ C$ SBT10100	I_{FSM}	135/150 A
Rating for fusing, $t < 10 ms$ Grenzlastintegral, $t < 10 ms$	$T_A = 25^\circ C$	i^2t	80 A ² s
Junction temperature – Sperrschichttemperatur Storage temperature – Lagerungstemperatur		T_j T_s	-50...+175°C -50...+175°C

1 $T_j = 25^\circ C$

2 Max. temperature of the case $T_C = 100^\circ C$ – Max. Temperatur des Gehäuses $T_C = 100^\circ C$

Characteristics
Kennwerte

Leakage current Sperrstrom	$T_j = 25^\circ\text{C}$ $T_j = 125^\circ\text{C}$	$V_R = V_{RRM}$ $V_R = V_{RRM}$	I_R I_R	< 100 μA typ. 5 mA
Thermal resistance junction to case Wärmewiderstand Sperrschicht – Gehäuse	R_{thC}			< 2 K/W

